

**1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д,
1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б,
ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж,
ГТ403И, ГТ403Ю**

Изменение статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 1Т403Е, 1Т403И при $U_{КБ} = 1 В, I_3 = 0,45 А$ не более
при $T = 343 К$ $\pm 30\%$
при $T = 213 К$ $+50\%$
 -40%

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5 В, I_3 = 0,1 А$ не менее **8 кГц**

Плавающее напряжение эмиттер-база при $U_{КБ} = 45 В$ 1Т403А, 1Т403Б, при $U_{КБ} = 60 В$ 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, при $U_{КБ} = 80 В$ 1Т403Ж, 1Т403И при $T = 343 К$ не более **0,3 В**

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ\max}$ не более при $T = 298 К$
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю **50 мкА**
при $T = 343 К$ **70 мкА**
 **800 мкА**

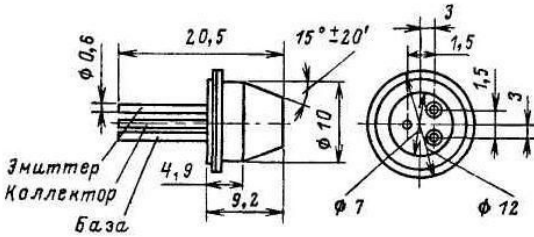
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 20 В$ 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю, $U_{БЭ} = 30 В$ 1Т403Д, ГТ403Д не более при $T = 298 К$
1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю **50 мкА**
при $T = 343 К$ **70 мкА**
 **800 мкА**

Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{КЭ} = U_{КЭ\max}$ 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403В, ГТ403Г, ГТ403Д, ГТ403Е, ГТ403Ж, ГТ403И, ГТ403Ю **5 мА**
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И **6 мА**

Транзисторы германиевые сплавные p-n-p усилительные низкочастотные маломощные.

Предназначены для работы в схемах переключения, выходных каскадах усилителей низкой частоты, преобразователях и стабилизаторах постоянного тока.

Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе
Масса транзистора не более 4 г.



Электрические параметры

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,5 А, I_B = 0,05 А$ не более **0,5 В**
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 0,5 А, I_B = 0,05 А$ не более **0,8 В**
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала при $U_{КБ} = 5 В, I_3 = 0,1 А, f = 50 - 300 Гц$:
1Т403А, 1Т403В, 1Т403Ж, ГТ403А, ГТ403В, ГТ403Ж **20-60**
1Т403Б, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403Б, ГТ403Г, ГТ403Д **50-150**
ГТ403Ю **30-60**

Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1 В, I_3 = 0,45 А$ 1Т403Е, 1Т403И, ГТ403Е, ГТ403И не менее **30**

Изменение коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Ж при $U_{КБ} = 5 В, I_3 = 0,1 А, f = 50 - 300 Гц$ не более:
при $T = 343 К$ $\pm 30\%$
при $T = 213 К$ -50%

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер 1Т403А, 1Т403Б, ГТ403А, ГТ403Б, ГТ403Ю **30 В**
1Т403В, 1Т403Г, ГТ403В, ГТ403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, ГТ403Д, ГТ403Е **45 В**
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И **60 В**

Постоянное напряжение коллектор-база 1Т403А, 1Т403Б, 1Т403В, 1Т403Г, 1Т403Д, 1Т403Е, 1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И **45 В**
1Т403В, 1Т403Е, 1Т403Г, 1Т403Д, ГТ403В, ГТ403Е, ГТ403Г, ГТ403Д **60 В**
1Т403Ж, 1Т403И, ГТ403Ж, ГТ403И **80 В**

Постоянное напряжение эмиттер-база **20 В**
1Т403Д, ГТ403Д **30 В**

Постоянный ток коллектора **1,25 А**

Постоянный ток базы **0,4 А**

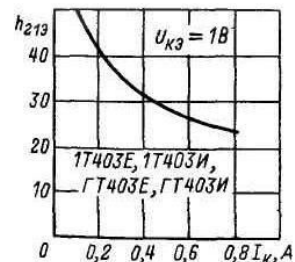
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом $(358 - T_K)/R_{T\text{п-к}}$, Вт
без теплоотвода $(358 - T)/R_{T\text{п-с}}$, Вт

Тепловое сопротивление переход-корпус **15 К/Вт**
1Т403В, 1Т403Е, ГТ403В, ГТ403Е **12 К/Вт**

Тепловое сопротивление переход-среда **100 К/Вт**

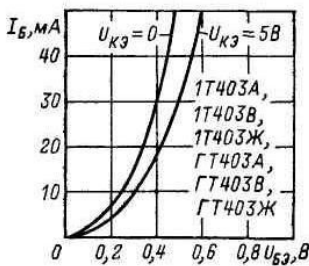
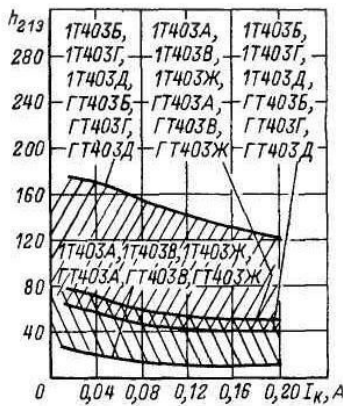
Температура перехода **358 К**

Температура окружающей среды 1Т403 **От 213 до 343 К**
ГТ403 **От 218 до 343 К**

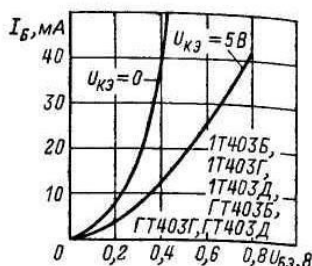


Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока коллектора

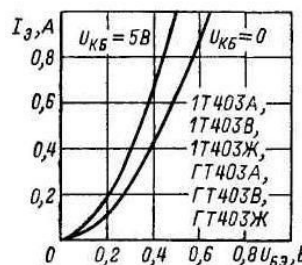
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента тока от тока коллектора.



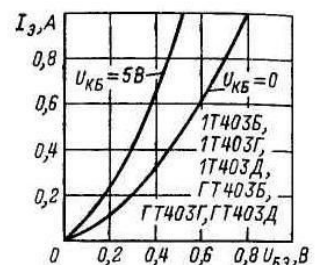
Входные характеристики



Входные характеристики



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер



Зависимость тока эмиттера от напряжения база-эмиттер